

THE UNITED SINVES OF AMERICA

TO AND TO WHOM THESE PRESENTS SHAVE COMES

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE

United States Patent and Trademark Office

July 19, 2004

THIS IS TO CERTIFY THAT ANNEXED HERETO IS A TRUE COPY FROM THE RECORDS OF THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE OF THOSE PAPERS OF THE BELOW IDENTIFIED PATENT APPLICATION THAT MET THE REQUIREMENTS TO BE GRANTED A FILING DATE UNDER 35 USC 111.

APPLICATION NUMBER: 60/487,708

FILING DATE: *July 16, 2003*

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

By Authority of the COMMISSIONER OF PATENTS AND TRADEMARKS

Certifying Officer

PATENT	APPLICATION	SERIAL NO.	•

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE PATENT AND TRADEMARK OFFICE FEE RECORD SHEET

07/21/2003 SFELEKE1 00000011 60487708 01 FC:1005 160.00 DP

> PTO-1556 (5/87)

PTO/BE/16 (10-01)
Approved for use through 10/31/2022, CMB 0651-0032

U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

PROVISIONAL APPLICATION FOR PATENT COVER SHEET

This is a request for filing a PROVISIONAL APPLICATION FOR PATENT under 37 CFR 1.53 (c).

Express Mail Label N . EV 328228493 US

			INVENT	OR(8)					£
Given Name (first and middl	Family Name or Sumame		Residence (City and either State or Foreign Country)					-	
Martan Mand		Deguniter Marited		Azien, Germany Azien, Garmany					7966 U.B.
Additional Inventors	ere being n	amed on the	separetely nui	mbered shee	ts attach	ed he	reto		2
		TITLE OF T	HE INVENTIO	N (500 chara	icters m	ex)			
	RLLUMINATE	NG SYSTEM FOR A	MCROLITHOGE	RAPHIC PROJE	BCTIONE	DIPOSI.	REA	PPRATUS	
Direct all correspondence to:	CORRESPONDENCE ADDRESS		3			Place Customer Number Bar Code Label here			
X Customer Number		22876							
OR	Туре С	ustomer Number I	nere ·						
Individual Name									
Address									
Address						- 1			
City			State			ZIP			
Country			Telephone			Fax			
X Specification Number		ENCLOSED AF	PLICATIONP	AKIS (CNOC	-				
X Specification Number X Drawing(s) Number	20			Numb (speci	specify) Return Postcard and Certificate of		te of		
Application Data Sho	et Sep 37	CER 1 76					L	Mailing by Express Mail	
METHOD OF PAYMENT OF			OVISIONAL A	PPLICATION	N FOR P	ATEN	Ť	······································	
Applicant ctalms sm									
X A check or money or	der la enclo	sed to cover the fil	ing fees					FILING FEE AMOUNT (\$)	160.00
The Commissioner I credit any overpaym				50-0545					
Payment by credit co	ard. Form F	TO-2038 is attach	red.						
The invention was made by a United States Government				under a cont	ract with	an ag	ency o	of the	
								•	
X No.				tract number s					
Yes, the name of the U	J.S. Governn	nent agency and the	Government con		B.G				
Yes, the name of the t	J.S. Governm	nent agency and the					F		
	J.S. Governm	nent agency and the	Government con Date	07/16/2	2003	N NC	Ţ		
Yes, the name of the t	J.S. Governn	nent agency and the		07/16/2 REGIST				34157	
Yes, the name of the t	ST	Factor		07/16/2 REGIST	2003 [RATIO]			34157	

USE ONLY FOR FILING A PROVISIONAL APPLICATION FOR PATENT

This collection of information is required by 37 CFR 1.51. The information is used by the public to file (and by the PTO to process) a provisional application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to take 8 hours to complete, including gathering, preparing, and submitting the complete provisional application to the PTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, Washington, D.C., 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Box Provisional Application, Assistant Commissioner for Patents, Washington, D.C. 20231.

In Re Apln. of:

Degunther, et al.

Ser. No.:

TO BE ASSIGNED

Filed on:

July 16, 2003

For:

ILLUMINATING SYSTEMFOR A

MICROLITHOGRAPHIC PROJECTION

EXPOSURE APPRATUS

Docket No.:

OST-031118PV

CERTIFICATE OF MAILING BY "EXPRESS MAIL"

Express Mail Mailing Label No. EV 328228493 US

Date of Deposit – July 16, 2003

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service, "Express Mail Post Office to Addressee" service under 37 C.F.R. 1.10 in an envelope addressed to MAIL STOP PROVISIONAL PATENT APPLICATION, Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA, 22313-1450, on the date identified above

enelle L. A. Melket

£793.4

- 1 -

1.6.07.2053

Seleuchtungseinrichtung für eine mikrolithographische Projektionsbelichtungsanlage

Die Arfindung betrifft eine Beleuchtungseinrichtung für eine mikrolithographische Projektionsbelichtungsanlage mit einem Lichtquelle zur Erzeugung eines Projektions-lichtbündels, einem ersten Objektiv und mit einer Maskensichtung zur Maskierung eines Retikels, die verstellbare erste Schneiden für eine Maskierung in einer ersten Reumrichtung und verstellbare zweite Schneiden für eine Maskierung in einer zweitan Raumrichtung umfaßt.

Eine derartige Beleuchtungseinrichtung ist aus der DE 195 10 20 563 Al bekannt.

Delauchtungseinrichtungen mikrolithographischer Projektionsbelichtungsenlagen, wie sie etwa bei der Herstellung
hochintegrierter elektrischer Schaltkneise verwandet werden, dienen der Erzeugung eines Projektionslichtbündels,
das auf ein Retikel gezichtet wird, welches die zu projizierenden Strukturen enthält. Mit Hilfe eines Projektichschiektivs werden diese Strukturen auf eine lichtempfindliche Oberfläche verkleinert abgebildet, die z. B.
auf einen Wafer aufgebracht sein kann.

Die aus der vorstehend genannten DE 195 20 563 Al bekannte Beleuchtungseinrichtung umfaßt einen als Lichtquelle dienenden Laser, eine Strahlformungseinrichtung, ein

as:Arr/2793IIA

- ? -

1€.07.2003

Zcom-Arikon-Objektiv zur Einstellung unterschiedlicher Seleuchtungsarten sowie einen Stabbomogenisierer, mit dem dss von dam Laser arzeugte Projektionslicht gemischt und homogenisiert wird. In lichtausbreitungsrichtung hinter 3 dem Stabhomogenisierer ist eine Maskeneinrichtung angeordnat, mit der sich die Geometrie des das Retikel durchtratenden Lichtfeldes fastlegen 188t. Bei den bekannten Maskemeitrichtungen, wie sie etwa in der US 5 473 410 A beschrieben sind, wird die Ausdehnung des Lichtfeldes auf to dem Ratikel in einer ersten Raumrichtung durch ein erstes Pair von Schneiden festgelegt, deren Abstand veränderbar ist. Ein zweites Paer von Schneiden, deren Abstand ebenfalls veranderbar 1st, legt die Ausdehaung des Lichtfeldes in der dazu senkrechten Raumrichtung fest. Mit Hilfe 15 eines nachfolgenden Maskenobjektivs werden die Schneiden der Maskeneinrichtung auf des zu beleuchtende Retikel abgebildet und erzeugen dort eine randscharfe Begrenzung des Lichtfeldes.

Moderne Projektionsbelichtungsanlagen sind häufig (such)

für einen Scan-Betrieb ausgelegt, bei dem das Retikel

derart an einer Lichtaustrittsöffnung der Beleuchtungseinrichtung vorbeigeführt wird, daß ein schmaler Lichtstreifen das Retikel scannerartig überstreicht. Ein derartiger Scan-Betrieb erfordert, daß zu Anfang und zu Beginn eines jeden Scan-Vorgangs jeweils eine der senkracht
zur Scan-Richtung angeordneten Schneiden der Maskeneinrichtung entlang der Scan-Richtung verstellt wird, damit
die gesamte auszuleuchtende Fläche des Retikels der glei-

- 3 -

16.07.2003

chen Bestrahlung, d.h. Strahlungsonerçia pro Flächeneinheit, ausgesetzt wird.

De bei modernen Projektionsbelichtungsanlagen im Hinblick auf einen hohen Durcheatz große Scan-Geschwindigkeiten sudtreten, eine die in Scan-Richtung verstellbaren Schneiden einer hohen dynamischen Belastung ausgesetzt. Die für diese Verstellbarkeit erforderliche Mechanik in den Naskeneinrichtungen ist deswogen konstruktiv relativ aufwendig, teuer in der Herstellung und benötigt überdies auch relativ viel Beuraum innerhalb der Beleuchtungseinrichtung. Die Ancrdnung anderer benachbarter optischer Elemente kenn deswegen schwierig werden.

Sei sinem solchen optischen Element kann es sich beispielaweise um eine Abachwächeinzichtung zur lokal veränderbaren Abschwächung der Lichtintenzität handeln, wie er
heispielsweise aus der US 5 895 737 A bekannt ist. Diese
bekonnte Abschwächeinzuchtung ist in der Feldebene der
Beleuchtungseinrichtung, in der sich die Maskeneinrichcung befindet, anzucrdnen und weist eine Vielzahl kleiner
Stäbe auf, die einzeln in das Lichtfeld eingeführt werden
können. Durch die Stäbe läßt eich die Lichtintensität
während des Scanvorgangs gezielt an die zu projizierenden
strukturen auf dem Retikel anpassen. Die gemeinsame Ancrimung einer Maskeneinrichtung mit einer derartigen Abschwächeinrichtung in der Feldebene vor dem Maskenobjektiv bereitet allerdings in der praktischen Umsetzung be-

of the Company

3733.4

- 4 --

16.07.2003

trachtliche Schwierigkeiten auf Grund von Bauraumproblemen.

Aufgabe der Erfindung ist es deswegen, eine Beleuchtungssinrichtung der eingangs genannten Art derert zu verbess sern. daß die konstruktiven Schwierigkeiten im Bereich der Feldebene vor dem Maskenobjektiv auf Grund von Bauraumproblemen verringert werden.

Gelbat wird diese Aufgabe bei einer Beleuchtungseinrichtung der eingangs genannten Art dadurch, daß die ersten Schneiden im Bereich einer ersten Faldebene und die zweiten Schneiden im Bereich einer zweiten Feldebene angeordnet sind, die von der ersten Feldebene verschieden ist.

Diese Aufteilung der für die unterschiedlichen Raumrichtungen vorgesehenen Schneiden auf unterschiedliche Felderenen ermöglicht es, die Maskeneinrichtung räumlich zu entzerren. Die für die Verstellearkeit der Schneiden erforderliche Mechanik in der Maskeneinrichtung kann deswegen konstruktiv einfacher und damit preisgünstiger ausgeführt werden. Überdies erlaubt es die erfindungsgemäße Aufteilung der Maskeneinrichtung auf zwei Feldebenen, zusätzlich in einer Faldebene anzuordnende Einheiten wie atwaldie oben erwähnten Abschwächeinrichtung leichter in die Beleuchtungseinrichtung zu integrieren.

Die erste und die zweite Feldebene können unmittelbar, 25 d. h. ohne weitere dazwischen liegende Feldebenen, be-

. . . .

6.793.4

_ 5 ..

15.07.2003

nachbart sein und durch min einziges Objektiv aufeinander mögebildet werden. Grundsätzlich ist es jedoch auch möglich, das sich zwischen den beiden Feldebenen weitere Feldebenen befinden, die durch eine entsprechende Anzahl von zusätzlichen Objektiven aufeinander abgebildet werden.

Basondars einfach läßt sich die erfindungsgemäße Beleuchtungseinrichtung reslisieren, wenn das erste Objektiv ein in Strahlausbreitungsmichtung vor dem ersten Objektiv eniv geordnetes ersies optisches Rasterelement auf die erste Feldabene abbilder und die Beleuchtungseinrichtung ferner ein in Strahlausbreitungsrichtung hinter dem ersten Objektiv angeordnetes zweites Objektiv aufweist, das die erste Feldebene auf die zweite Feldebene abbildet. Bei 15 dam ersten optischen Rasterelement kann es sich z. 3. um ein refraktives Element, etwa in der Art eines Mikrolinsenarrays, ein diffraktives Elementes (Gitter), ein Kinoform oder ein Hologramm handeln. Mit einem solchen an sich bekannten optischen Rasterelement kann die Lichtver-20 teilung des von der Lichtquelle stammenden Projektionslichtbündels z. B. in eine kreis-, ring- oder gradrupolformige Divergenzverteilung umgeformt werden.

Im Frinzip ist es möglich, daß in dem ersten Objektiv mit Hilfe eines geeigneten optischen Rasterelements die Divergenz des Projektionslichtbündels so erhöht wird, daß bereits dort der meximale Lichtleitwert des gesamten optischen Systems erreicht wird.

.. 6 -

16.07.2003

Desonders bevorzugt ist as allerdings, wenn in dem ersten Objektiv ein zweites optisches Rasterelament angeordnet ist, das ein hindurchtretendes Projektionslichtbündel ausschließlich in der ersten Raumzichtung aufweitet, und 5 wann in dam zweiten Objektiv ein drittes optisches Rastorglement angeordnet ist, das ein hindurchtretendes Projektionslichtbündel ausschließlich in der zweiten Raumrichtung aufweitet, wobei das zweite und das dritte cptische Easterelement vorzugsweise in der Nähe einer Pupillerabene angeordnet sind. Durch das Vorsehen zweier in unterschiedlichen Raumrichtungen wirkender Rasterelemente wird der maximale Lichtleitwert due optischen Systems erst Hinter dem dritten optischen Resterelement erzielt. Ewischen dem zweiten optischen Resterelement und dem 15 dritten optischen Resterelement ist der Lichtleitwert lediglich in der ersten kaumrichtung vergrößert. Dies erlaubt es, die zwischen dem zweiten optischen Rasterelement und dem dritten optischen Rasteralement angeordneten optischen Elemente einfacher und kostengünstiger aufzu-20 bauen. da die Anforderungen an die Komplexität und Genzuigkert optischer Elementa mit steigendem Lichtleitwert zunelwen.

Wenn durch die ersten und die zweiten Schneiden ein im wesentlichen streifenförmiges Lichtfeld auf dem Retikal 25 festleghar ist, dessen Ausdehnung in der ersten Raumrichtung hürzer als in der zweiten Raumrichtung ist, so fällt die durch das zweite optische Rasterslement eingeführte Erhöhung des Lichtleitwertes kaum ins Gawicht, da in die-

- 7 -

16.07.2003

sem Fall das zweite optische Rasterelement das Projektionslichtbündel nur um einen relativ kleinen Winkelbetrag
aufweiter. Für die zwischen dem zweiten und dem dritten ;
optischen Rasterelament liegenden optischen Elemente ist
diese geringfügige Erhöhung des Lichtleitwerts in dieser
ersten Raumrichtung praktisch vernachlassigbar.

Diese Ausgestaltung der Erfindung hat ferner den Vorteil, daß die relativ aufwandige Mechanik für die Verstellung der ersten Schneiden, die das Lichtfeld auf dem Retikel in der ersten Raumrichtung (Scan-Richtung) begrenzen und die zu Beginn und am Ende eines jeden Scan-Vorgangs präzise und schneil verstellt werden müssen, genügend Platz finder in dem zwischen dem ersten Objektiv und dem zweiten Objektiv verbleibenden Freiraum.

In der zweiten Feldebene sind darn nur noch die Schneiden anzuordnen, die die Maskierung in der dazu senkrechten Raumrichtung bewirken und die im allgemeinen nicht während eines Scan-Vorgangs verstellt werden müssen. Die hierzu erforderliche Mechanik ist im allgemeinen einfacher aufgebaut als die Hechanik für die Verstellung der ersten Schneiden, so daß im Bereich der zweiten Feldebene der kleinere Teil der Maskaneinrichtung angeordnet ist.

Diese zweite Feldebene ist Geswegen besonders geeignet für die Aufnahme weiterer optischer Raugruppen, die in einer Feldebene oder in deren Nähe angeordnet werden müsB793.4

We work to be a

- 3 -

16.07.2003

sen. Ein Beispiel hierfür ist die bereits oben erwähnte Abschwächeinrichtung.

Besonders bevorzugt ist as ferner, wenn das erste und das zweite Objektiv so ausgelegt sind, daß des Lichtfeld in 5 der eraten Feldebene klainer ist als das Lichtfeld in der zweiten Feldebene. Dies kann beispielsweise dadurch erreicht werden, daß das zweite Objektiv einen Abbildungsmaßstab har, der größer ist als 1. Ein relativ kleines Lichtfeld in der ersten Feldebene hat nämlich den Vor-10 teil, daß die dort angeordneten ersten Schneiden zur Ermislung der gleichen Waskierungswirkung auf dem Retikel kleinere Verstellwege benötigen, als wenn die ersten Schneiden in der zweiten Feldebene angeordnet wären, wo das Lichtfeld größer ist. Auch die Abmessungen der ersten 15 Schneiden können bei dieser Weiterbildung kleiner gewählt werden als sonst üblich. Somit kann der gesamte, die ersten Schneiden betreffende Teil der Maskenminrichtung kleiner, kompakter und damit auch kostengünstiger ausgeführt werden.

Andererseits gibt es andere optische Baugruppen, z. 3.

die bereits erwähnte Acschwächeinrichtung, die möglichst
in oder nahe einer Feldebene angeordnet sein sollten, in
der das Lichtfeld vergleichsweise groß ist. Bei einer Acschwächeinrichtung der genannten Art ist es nämlich kaum
möglich, die Abmessungen der zehlreichen kleinen Stäbe,
die in das Lichtfeld eingeführt werden können, über das
bereits erreichte Maß hinaus zu verzingern.

. 9 -

16.07.2003

Vorteilhaft kann ferner in dem zweiten Objektiv ein Manipulator zur Manipulation der Pupille angeordnet sein. Bei
einem solchen Manipulator kann es sich z. B. um ein Grauwertfilter handeln, das pupillennah, z. B. benachbart zu
dem dritten optischen Rosterelement, in dem zweiten Objektiv angeordnet werden kann. Mit anderen an sich im
Stand der Technik bekannten Manipulatoren kann z. B. die
Telerentrie verändert werden.

Dei dem ersten Objektiv handelt es sich vorzugsweise um ein Zoom-Axikon-Objektiv mit zwei relativ zueinander verstellbaren Axikon-Linsen. Bevorzugt ist weiter, wenn die beider Axikon-Linsen im einer Pupillenebene des Zoom-Axikon-Objektivs angeordnet sind. Das zweite optische Rasterslement, das abenfalls pupillennah positioniert sein sollte, kann dann entweder unmittelbar vor oder hinter den Axikon-Linsen in den ersten Objektiv angeordnet sein.

Zur Abbildung der zweiten Feldebene auf eine dritte Feldebene, in der das Retikel angeordnet ist, ist vorzugsweise um drittes Objektiv vorgesehen, wie dies im Stand der Technik an sich bekannt ist.

Weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung eines Ausführungsbeispiels anhand der Zeichnung. Darin zelgen:

16.07.2003

- 10 -

P793.4

- Figur 1 einen Meridionalschmitt einer erfindungsgemäßen Beleuchtungseinrichtung in stark schemmtisierter und nicht maßstäblicher Darstellung;
- Figur 2 die Geometrie eines Lichtfeldes, das von der in der Figur 1 gezeigten Beleuchtungseinrichtung erzeugt werden kann;
 - Figur 3 eine Draufsicht auf das zweite optische Rasterelement der in der Figur 1 geseigten Beleuchtungseinzichtung:
- 10 Figur 4 einen Schnitt durch das in dem Figur 3 gezeigte zweite optische Rasterelement entlang dem Linie IV-IV;
- Figur 5 eine Draufsicht auf das dritte optische Rasterelement der in der Figur 1 gezeigten Beleuchtungseinrichtung:
 - Figur 6 einem Schnitt durch das in der Figur 5 gezeigte dritte optische Rastenelement entlang der Linie VI-VI.
- In Figur 1 ist eine insgesamt mit 10 bezeichnete Beleuchtungseinrichtung in einem Meridionalschnitt stark vareinfach', und nicht maßstäblich dargestellt. Die Beleuchtungseinrichtung 10 ist für eine Projektionsbelichtungsanlage vorgesehen, die eine Belichtung lichtempfindlicher

•

- 11 -

16.67.2003

Orandizchen im Scan-Betrieb ermöglicht. Grundsätzlich jedoch kenn die Beleuchtungseinrichtung 10 auch in lediglich schrittweise erbaitenden Projektionsbelichtungsanla-, gen eingesetzt werden.

Die Beleuchtungseinrichnung 10 weist eine als Excimez-Laser ausgeführte Lichtquelle 12 auf, die Projektionslicht mit einer WollenlEnge im ultravioletten Spektrelbereich, z. 5. 193 nm cdam 157 nm, emzeugt. In einem Strahinufwetter 14, bei dem es sich z. E. um eine verstellbare Spiegelanordnung handeln kann, wind das von der Lichtquelle 12 erzeugte Projektionslicht zu einem rechteckigen und weingehend parallelan Strahlenbündel aufgeweitet. Das nomment aufgeweitete Projektionslicht durchtritt anschließend ein erstes optisches Rasterelement 16, bei dem 15 as sich z. B. um ein diffraktives optisches Element mit siner zweidimensionalar. Rasterstruktur handeln kann, wie es in der eingengs bereits erwähnten DE 195 20 563 Al beschrieben ist. Mit diegem ersten optischen Rasterelement 16 kann die Divergenzwerteilung von der Lichtquelle 12 20 stammenden Projektionslichts z. S. in eine kreis-, ringoder quadrupolförmige Divergenzverteilung umgeformt werien.

Das erste optische Rasierelement 16 ist in einer Objektsbene 18 eines Zoom-Amikon-Objektivs 20 angeordnet, mit dem sich die Beleuchtungswinkelverteilung verändern läht. Rierzu weist das Zoom-Amikon-Objektiv 20 zwei relativ zueinender verschiebber angeordnete Amikon-Linsen 22, 24

- 12 -

1€.07.2003

auf, die in einer Fupillenebene 26 des Zoom-Axikon-Objektivs 20 angeordnet sind.

Unmittelbar vor den beiden Axikon-Linsen 22, 24, d. h. in der Nahe der Pupillenebene 26, ist ein zweites optisches 5 Rastarelement 28 angeordnet, durch welches ein hindurchtretendes Projektionslichtbündel lediglich in der X-Richtung aufgeweitst wird. Die X-Richtung ist die Scan-Richtung, in der ein mit 30 bezeichnetes Retikel während des Scan-Betriebs an der Seleuchtungseinrichtung 10 vor-10 beigeführt wird. Da das auf dem Retikel 30 abgebildete Lichtfeld, das in der Figur 2 gezeigt und mit 32 bezeichnet ist, in der Scan-Richtung (X-Richtung) nur eine relativ geringe Ausdehnung hau, braucht auch das zweite optische Rasterelement 28 das hindurchtretende Projektions-15 Lichtbündel nur relativ geringfügig in der X-Richtung aufzeweiten. Das zweite optische Rasterelement 28 vergrö-Bart den Lichtleitwert deswegen nicht nur lediglich in einer Raumrichtung, sondern in dieser auch zusätzlich nur um einen vergleichsweise kleinen Betrag.

Durch eine Linse oder Linsengruppe 34, die in dem Zoom-Axikon-Cojektiv 20 ausgangsseitig angeordnet ist, wird das erste optische Rasterelement 16 auf eine erste Feldebeng 35 abgebildet, in der eine insgesamt mit 38 angedeutete erste Maskeneinrichtung angeordnet ist. Die erste Maskeneinrichtung 38 anthält zwei sich entlang der Y-Richtung erstreckende Schneiden, die in X-Richtung motorisch verstellbar sind. Von diesen beiden Schneiden ist

- 13 -

15.07.2003

in dem Meridionalschnitt der Figur 1 lediglich eine jenselts der Papierebene Liegende Schmeide 40 erkennbar. Zu Beginn und am Ende eines jeden Scan-Vorgangs wird jeweils eine dieser beiden Schmeiden in X-Richtung motorisch vers stellt, um sicherzustellen, daß das Retikel 30 gleichmälig der gewünschten Bestmenlung ausgesetzt wird.

Die erste optische Maskeneinrichtung 36 muß nicht unbedingt enakt in der ersten Feldebene 26 angebrähet sein, sondern kann auch um einige Millimeter bis maximal atwa 2 10 cm entlang der mit 41 bezeichneten optischen Achse ver-. setzt zu der Feldebene 36 angeordnet sein, da eine unscharfe Abbildung der ersten Schneiden 40 beim Scan-Betrieb durch den dabei erzielten Integrationsoffekt in der soan-Richtung nicht ins Gewicht fällt.

15 In Strahlausbreitungsrüchtung hinter der ersten Teldebene 36 ist ein zweites Objektiv 42 angeominet, das mit Hilfe mehrerer darin enthaltener nicht näher bezeichneter optischer Elemente dia exsta Feldebene 36 auf eine zweite Peldebene 44 abbildet. In einer Püpillenebene 46 inner-20 halb des zweiten Objektivs 42 ist ein drittes optisches Rasterelement 48 angeordnet, welches eine Aufweitung des Projektlonslichtbündels in der Y-Richtung, d. h. senkrecht zur Scan-Ruchtung, bewirkt. Ds. wie die Figur 2 zeigt, die Ausdehnung des Lichtfeldes auf den Retikel 30 25 in dieser Y-Richtung groß ist, çeht mit dieser Aufweitung des Projektionslichtbundels auch eine relativ starke Erböhung des Lichtleitworts einher. Da nach dem dritten op- 14 -

5793.4

16.07.2003

tischen Rasterelement 48 keine die Divergenz des Projektionslichtbündels beeinflussenden optischen Elemente in der Beleuchtungseinrichtung 10 angeordnet sind, wird unmittelber hinter dem dritten optischer Rasterelement 48 5 der maximale Lichtleitwert der Beleuchtungseinrichtung 10 erreicht.

Unmitteltar vor dem dritten optischen Rasterelement 48
ist innemhalb des zweiten Objektivs 42 noch ein Manipulator 50 angeordnet, mit dem sich die Eupille gerielt beainflussen läht. Dabei kenn es sich beispielsweise um einen Grauwertfilter handeln, der lokal über der Pupille
variferende Grauwertechet.

In der zweiten Feldebene 44 ist eine insgesamt mit 52 bezeichnete zweite Maskeneinrichtung angeordnet, mit der sich das Lichtfeld in der Y-Richtung maskieren läßt. Die zweite Maskeneinrichtung 52 weist zu diesem Zweck zwei Schneiden 54, 56 auf, die in Y-Richtung verstellbar sind. Da die Schneiden 54, 56 exakt in der Feldebene 44 angeordnet sind, werden diese durch ein nachfolgendes drittes Objektiv 58, das häufig auch als REMA-Objektiv (REMA angeordnet Masking) bereichnet wird, randscharf auf dem Retikel 30 abgebildet. Diese Abbildung wird mit Hilfe eines dritten Objektivs 58 erzielt, in dessen Objektebene sich die zweite Feldebene 44 und in dessen Bildebene sich das Retikel 30 befindet. Die zweite Maskeneinrichtung 52 sollte möglichst exakt in der Feldebene 44 angeordnet

-:-

16.07.2003

oder zumindest um nicht mehr als 1 mm dazu in Richtung der optischen Achse E3 versetzt sein.

In der zweiten Feldebene 44 ist ferner eine Abschwächeinrichtung 60 zur lokal veränderbaren Abschwächung der

5 Lichtintensität angeordnet, wie sie z. B. aus der oben
erwähnten US 5 473 410 A bekannt ist. Die Abschwächeinrichtung 60 kann auch garungfügig von der zweiten Feldebene 44 beabstandet sein, da die in der Abschwächeinrichtung 60 enthaltenen Abschwächelsmante, z. B. in das
10 Lichtseld einführbare Stäbe, nicht scharf auf dem Retikel
30 abgebildet zu werden brauchen.

Die Figuren 3 und 4 zeigen das zweite optische Rasterelement ?8 in einer Draufzicht bzw. in einem Schnitt entlang
der Linie IV-IV. Das zweite optische Rasterelement 28 ist
in diesem Ausführungsonispiel als refraktives Element
ausgeführt, das einen Träger 62 sowie eine Vielzahl parailel darauf angeordneter Zylinderlinsen 64 umfaßt, die
im eingebauten Zustand in Y-Richtung verlaufen. Da die
Zylinderlinsen 64 nur relativ schwach gekrümmt sind, wird
das hindurchtretende Projektionslicht in der X-Richtung
nur vergleichsweise schwach aufgeweitet.

Lie Figuren 5 und 6 zeigen das dritte optische Rasterelement 48 in einer Draufsicht bzw. in einem Schnitt entlang der Linia VI-VI. Das dritte optische Rasterelement 48 ist Ahnlich aufgebaut wie das zweite optische Rasterelement 28. Das dritte optische Rasterelement 48 umfalt ebenfalls

- 16 -8793.4

16.07.2003

eine Vielzahl von auf einem Träger 66 aufgebrachten Zylinderlinsen 69. Diese weisen allerdings eine stärkere Krümmung als die Zylinderlinsen 64 des zweiten optischen. Rasterelaments 23 auf, so daß hindurchtretendes Projekti-5 onslicht stärker aufgeweitet wird. Außerdem wird das dritte optische Rasterelament 48 so in die Beleuchtungseinmichtung 10 eingebeut, daß die Längsrichtung der Zylinderlingen 68 um 90° verdreht bezüglich der Längsrichtung der Zylinderlinsen 64 des zweiten optischen Rastez-10 elements 28 angeordnet sind. Die beiden optischen Resterelemente 28 und 48 unterscheiden sich somit nicht nur durch den Grad der Aufwaltung, sondern auch durch die Richtong, in der das hindurchtretende Projektionslichtbundel sufgeweitet wird.

16.07.2063

Patenzansprüche

李叶江 水板 日本 本日 年 日 年 日 日 年 日 日

2. Deleuchtungseinrichtung für eine mikrolithographische Projektionsbelichtungsanlage, mit einer Lichtquelle (12) zur Erzeugung eines Projektionslichtbündels,
einem ersten Objektiv (20) und mit einer Maskeneinrichtung (38, 52) zur Maskierung eines Retikels (30), die
verstellesre erste Schneiden (40) für eine Maskierung in
einer ersten Raummichtung (X) und verstellbare zweite
Schneiden (54, 56) für eine Maskierung in einer zweiten
Raummichtung (Y) umfaßt,

10 dedurch gekennzeichnet,

des die ersten Schneiden (40) im Bereich einer ersten Felcebene (36) und die zweiten Schneiden (54, 56) im Bereich einer zweiten Feldebene (46) angeordnet sind, die von der ersten Feldebene (36) verschieden ist.

2. Beleuchtungseinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das erste Objektiv (20) ein in
Strahlausbreitungsrichtung vor dem ersten Objektiv (20)
angeordnetze erstes optisches Rasterelement (16) auf die
erste Feldebene (36) abbildet, und daß die Beleuchtungsceinrichtung (10) ferner ein in Strahlausbreitungsrichtung
hinter dem ersten Objektiv (20) angeordnetes zweites Objektiv (42) aufweist, das die erste Feldebene (36) auf
die zweite Feldebene (44) abbildet.

.=

2793.(.. 2 -

1€.07.2003

- 3. Beleuchtungseinrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß in dem ersten Objektiv (20) ein
 zweites optisches Rasterelement (28) angeordnet ist, das
 ein hindurchtretendes Lichtbündel ausschließlich in der
 5 ersten Reumrichtung (X) aufweitet, und daß in dem zweiten
 Objektiv (42) ein drittee optisches Rasterelement (42)
 angeordnet ist, das ein hindurchtretendes Lichtbündel
 ausschließlich in der zweiten Raumrichtung (Y) aufweitet.
- 4. Beleuchtungswinnichtung mach Anspruch 3, dadurch gekannzeichnet, daß das zweite optische Rasterelement
 (26) pupillennsh innerhalb des ersten Objektivs (20) und
 das dritte optische Rästerelement (48) pupillennah innerhalb des zweiten Objektivs (42) angeordnet ist.
- 5. Beleuchtungseinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, das durch die
 ersten Schneiden (40) und durch die zweiten Schneiden
 (54, 56) ein im wesentlichen streifenförmiges Lichtfeld
 (32) auf dem Retikel (30) festlegbar ist, dessen Ausdehnung in der ersten Raumrichtung (X) kürzer als in der
 zweiten Raumrichtung (Y) ist.
- 6. Baleuchtungseinrichtung nach einem der vorhergehanden Ansprüche, dadurch gekennzelchnet, daß in der zweiten Faldebene (44) eine Abschwächelnrichtung (60) zur lokal veränderbaren Abschwächung der Lichtintensität angeordnet ist.

\$793.4

·- 3 -

16,07,2003

- 7. Beleuchtungseinrichtung nach einem der verhergehenden Amsprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das erste
 Objektiv (20) und das zweite Objektiv (42) so ausgelagt :
 sind, daß das Lichtfeld in der ersten Faldebene (36)
 5 kleiner ist als das Lichtfeld in der zweiten Feldebene
 (44).
- 8. Beleuchtungseinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, das in dem zweiten Objektiv (42) ein Namipulator (50) zur Manipulator tion der Pupille angebrinet ist.
 - 5. Delauchtungseinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das erste Objektiv sin 200m-Aktikon-Objektiv (20) mit zwei relativ zueinander verstellbaren Axikon-Linsen (22, 24) ist.
- 15 10. Belauchtungseinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Beleuchtungseinrichtung (10) ein drittes Objektiv (58) zufucist, das die zweite Feldebene (44) auf eine dritte
 Feldebene abbildet, in der das Retikel (30) angeordnet
 20 ist.

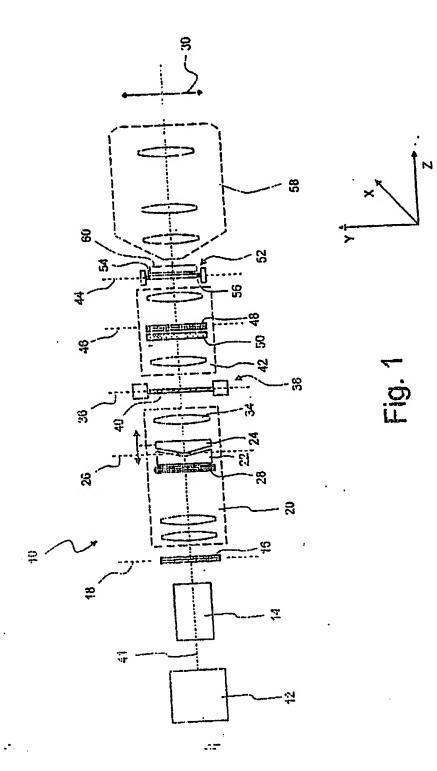
·- <u>7</u> ·-

16.07.2063

Zusammenfasaung

Time Beleuchtungseinrichtung für eine mikrolithographische Projektionsbelichtungsenlage umfalt eine Lichtquelle (32) tur Erzeugung eines Projektionslichtbündels, ein erstas Objektiv (20) und mine Maskeneinrichtung (38, 52) 5 Zur Hasklerung eines Retikels (30). Die Meskeneinrichtung (33, 52) weist verstellbare erste Schneiden (40) für eine Maskleaung in einer ersten Reumrichaung (X) und verstellbare swalte Schnelden (54, 56) for eine Maskierung in einer zweiten Raumrichtung (Y) auf. Die ersten Schneiden 10 (4C) sind dabel im Bereich einer ersten Feldebene (36) und die rweiten Schneiden (54, 56) im Bereich einer zweiten Felcebene (44) angeordnet, die von der ersten Feldebene (35) verschieden ist. Die Maskeneinrichtung läßt sich somit räumlich entwerren, wedurch konstruktiven 15 Schwiezigkeiten im Bereich der Feldebene vor dem Maskenobjektiv zuf Grund von Bauraumproblemen verringert wer-

(Figur 1)



3793.4

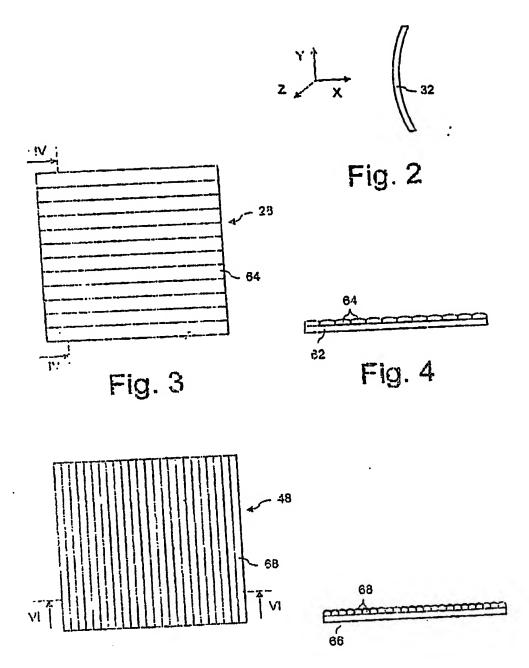


Fig. 5

-:-

Fig. 6

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.